



Toshiba Memory Europe presenta la solución de memoria para almacenamiento XL-FLASH

La NAND de mayor rendimiento disponible también reduce de manera rentable la latencia

Düsseldorf, Alemania, 05 de Agosto de 2019 – Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva solución de memoria para almacenamiento (SCM): XL-FLASH™. Basado en la innovadora tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de la compañía con SLC de 1 bit por celda, XL-FLASH brinda baja latencia y alto rendimiento para aplicaciones de centro de datos y almacenamiento empresarial.

Clasificada como SCM (o memoria persistente), con una capacidad de retener su contenido similar a la memoria flash NAND, XL-FLASH cierra la brecha de rendimiento que existe entre DRAM y NAND. Si bien las soluciones de memoria volátil, como DRAM, proporcionan la velocidad de acceso que necesitan las aplicaciones exigentes, ese rendimiento tiene un alto costo. A medida que el costo por bit y la escalabilidad de la DRAM se nivelan, esta nueva capa SCM en la jerarquía de memoria resuelve ese problema con una solución de memoria flash NAND no volátil, de alta densidad y rentable. Preparada para crecer, la firma de analistas de la industria IDC estima que el mercado SCM alcanzará más de 3.000 millones de dólares en 2022 ^[1].

Posicionado entre DRAM y flash NAND, XL-FLASH brinda mayor velocidad, menor latencia y mayores capacidades de almacenamiento, a un coste menor que la DRAM tradicional. XL-FLASH se implementará inicialmente en un formato SSD, pero podría ampliarse a dispositivos conectados al canal de memoria que se encuentran en el bus DRAM, como los futuros módulos de memoria en línea duales no volátiles (NVDIMM).

Características clave

- **Pastilla de 128 gigabits (Gb)** (en un encapsulado de 2, 4 u 8 pastillas)
- **Tamaño de página de 4 KB** para lecturas y escrituras más eficientes del sistema operativo
- **Arquitectura de 16 planos** para un paralelismo más eficiente
- **Lectura rápida de la página y tiempos de programación**, XL-FLASH proporciona una baja latencia de lectura de menos de 5 microsegundos, aproximadamente 10 veces más rápido que el TLC^[2] existente

Como inventor de NAND flash, además de ser la primera compañía en anunciar la tecnología de memoria flash 3D y líder en migraciones de procesos, Toshiba Memory está en una posición ideal para ofrecer SCM basado en SLC con fabricación madura, escalabilidad probada y fiabilidad probada en el tiempo. .

" XL-FLASH, es la NAND de mayor rendimiento disponible, gracias a nuestra BiCS FLASH – utilizada en modo SLC", afirmó Axel Stoermann, Vicepresidente, Toshiba Memory Europe GmbH. "Mediante el solo almacenamiento de 1 bit por celda, estamos incrementando enormemente el rendimiento. Y debido a que XL-FLASH está basado en tecnologías probadas que ya fabricamos en masa, nuestros clientes serán capaces de acelerar el lanzamiento al mercado de sus productos con la adopción de XL-FLASH una solución de memoria de almacenamiento ".

Los envíos de muestra comenzarán en septiembre de 2019, y se espera que la producción en masa comience en 2020.

Notas:

[1] IDC, mayo de 2019 - Pronóstico mundial de unidades de estado sólido, 2019-2023, documento n.o US43828819

[2] En comparación con TLC NAND de TMC, que tiene una latencia de lectura de aproximadamente 50 microsegundos.

NAND de mayor rendimiento disponible basada en el hecho de que la pastilla ha sido diseñada específicamente (16 planos) para proporcionar un mayor rendimiento que TLC NAND.

Todos los nombres de compañías, productos y servicios pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

En cada mención de un producto de memoria Toshiba: la densidad del producto se identifica en función de la densidad de los chips de memoria dentro del producto, no de la cantidad de capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por parte del usuario final. La capacidad utilizable por el consumidor será menor debido a las áreas de datos generales, el formato, los bloques defectuosos y otras restricciones, y también puede variar según el dispositivo host y la aplicación. Para más detalles, consulte las especificaciones del producto correspondiente. La definición de 1 Gb = 2^{30} bits = 1.073.741.824 bits. La definición de 1GB = 2^{30} bytes = 1.073.741.824 bytes. La definición de 1 KB = 2^{10} bytes = 1.024 bytes.

###

Sobre Toshiba Memory Europe

Nosotros, Toshiba Memory Europe GmbH, somos la división europea de Toshiba Memory Corporation. Nuestra compañía ofrece una amplia línea de productos de memoria flash de gama alta, que incluyen tarjetas SD, memorias USB y componentes de memoria embebidos, además de unidades de estado sólido (SSD). Nuestra empresa tiene oficinas en Alemania, Francia, España, Suecia y el Reino Unido. El presidente de la compañía es Masaru Takeuchi.

Para obtener más información sobre la gama completa de nuestros productos de memoria y SSD, visite business.toshiba-memory.com

Datos de contacto para publicación:

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0)211 368 77-0 Fax: +49 (0) 211 368 774 00

E-mail: support@toshiba-memory.com

Datos de contacto para peticiones editoriales:

Sandrine Aubert, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 579

E-mail: SAubert@toshiba-tme.eu

Emitido por:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

Ref. TME035A_SPA